

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 17 年 3 月 3 日 (2005.3.3)

【公表番号】特表 2004-508720 (P2004-508720A)
 【公表日】平成 16 年 3 月 18 日 (2004.3.18)
 【年通号数】公開・登録公報 2004-011
 【出願番号】特願 2002-524235 (P2002-524235)
 【国際特許分類第 7 版】

H 0 1 L 33/00

【F I】

H 0 1 L 33/00 C

【手続補正書】

【提出日】平成 15 年 3 月 31 日 (2003.3.31)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 2 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2 0】

多数の導電性の領域が、InGa_{1-x}N ベースの材料、InN または GaN から形成されている、請求項 1 9 記載の半導体チップ。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 2 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2 1】

多数の導電性の領域が、導電性の領域が形成されるように低い Al 含有量を有する In_{1-x-y}Ga_xN [式中、0 < x < 1] または In_{1-x-y}Al_xGa_yN [式中、0 < x < 1、0 < y < 1、x + y < 1] から形成されている、請求項 2 0 記載の半導体チップ。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 2 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2 2】

緩衝層 (9) が、多重に、AlGa_{1-x}N ベースの多数の個別層から形成されている、請求項 1 9 から 2 1 までのいずれか 1 項記載の半導体チップ。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 2 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2 3】

薄層素子 (1 1) に隣接する個別層 (9) が、薄層素子の層から見て、前記個別層の後に配置された個別層より低い Al 含有量を有している、請求項 2 2 記載の半導体チップ。

【手続補正 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 2 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2 4】

支持体（５）が、発生する放射線に対して透過性であるかまたは一部透過性である、請求項 1 9 から 2 3 までのいずれか 1 項記載の半導体チップ。

【手続補正 6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 2 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2 5】

支持体（５）が、発生した放射線を反射する層を有している、または少なくとも部分的に発生した放射線を反射する表面を有している、請求項 1 9 から 2 4 までのいずれか 1 項記載の半導体チップ。